РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. К.А. ВАЛИЕВА



Основаны в 1991 году Главный редактор член-корреспондент РАН В.Ф. ЛУКИЧЁВ

Том 31

КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ, МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКА

физика, технология, диагностика и моделирование

Ответственный редактор доктор физико-математических наук Т.М. МАХВИЛАДЗЕ

МОСКВА НАУКА 2023

Рецензенты: доктор технических наук П.П. Мальцев, доктор физико-математических наук К.В. Руденко

Труды Физико-технологического института / гл. ред. В.Ф. Лукичёв ; Физикотехнологич. ин-т им. К.А. Валиева РАН. – М. : Наука, 1991 – . – ISSN 0868-7129.

Т. 31: Квантовые компьютеры, микро- и наноэлектроника : физика, технология, диагностика и моделирование / отв. ред. Т.М. Махвиладзе. – 2023. – 135 с. – ISBN 978-5-02-040972-9.

Том 31 Трудов ФТИАН посвящен актуальным проблемам технологии нано- и микроэлектроники. В сборник включены статьи, в которых представлены последние результаты сотрудников института по разработке физических основ, моделированию и оптимизации процессов формирования, функционирования и технологии изготовления перспективных элементов, структур, приборов и устройств нано- и микроэлектроники, их деградации и долговечности в ходе эксплуатации. Большое внимание уделено, в частности, результатам, относящимся к исследованию устойчивости интерфейсных структур, которая во многом определяет время жизни актуальных планарных и объемных ИС в условиях сильного электромиграционного массопереноса и механических воздействий.

Для широкого круга специалистов в области квантовых информационных технологий, микро- и наноэлектроники, а также студентов и аспирантов, обучающихся по соответствующим специальностям.

ISBN 978-5-02-040972-9

- © Физико-технологический институт им. К.А. Валиева РАН, 2023
- © Российская академия наук и издательств о «Наука», продолжающееся издание «Труды ФТИАН» (разработка, оформление), 1991 (год основания), 2023
- © ФГБУ Издательство «Наука», редакционно-издательское оформление, 2023

УДК 538.975

Н. Г. САВИНСКИЙ¹, Е.А. ГРУШЕВСКИЙ

НАНОУГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ В ЭЛЕКТРОНИКЕ

¹ Ярославский филиал Физико-технологического института им. К. А. Валиева РАН

Введение

В Ярославском филиале Физико-технологического института им К.А. Валиева в Лаборатории тонких пленок в течение нескольких последних лет проводился ряд исследований, посвященных наноуглеродным материалам, способам их получения, идентификации физико-химическими методами и технологии использования этих материалов в электронике и других приложениях. Основное направление исследований было сосредоточено на разработке нанодисперсных углеродных материалов на основе производных графена. С некоторыми результатами этих работ авторы познакомят читателя в данной статье.

Уникальные электронные, механические, оптические, теплофизические свойства графена делают его кандидатом номер один для: композиционных материалов, накопителей энергии, очистки и дистилляции воды и других жидкостей, солнечных элементов, медицинских направлений, защиты от электромагнитных помех, коррозионностойких покрытий, сверхпроводников, следующей генерации электронных, оптоэлектронных приборов и сенсорики [1]. В работе [1] отражены некоторые результаты создания композиционных материалов для защиты от высокочастотного электромагнитного излучения. С развитием электромагнитных технологий проблема электромагнитной безопасности становится все более актуальной. Таким образом, роль электромагнитного поглощения привлекает все больше внимания в военной и гражданской сферах. Покрытие, поглощающее электромагнитные волны, как важное средство поглощения радиолокационных волн имеет широкий спектр применения. Поскольку в природе мало материалов, способных реагировать на терагерцовую частоту, и поскольку существует нехватка эффективных источников и детекторов терагерцового диапазона, эффективное управление терагерцовыми волнами по-прежнему остается большой проблемой.

[©] Н.Г. Савинский, Е.А. Грушевский, 2023

В последнее время графен был продемонстрирован в качестве жизнеспособной альтернативы при реализации ТГц-поглотителей из-за его высокого ТГц-поглощения и устойчивости поверхностной проводимости. Рассматривается метод, основанный на создании материалов с широким диапазоном регулируемых электрических и магнитных свойств: проводящие полимеры (полианилины), слоистый нанографит, наноструктурированные гранулированные композиты.

1. Материалы для исследований

Полианилин (PANI). Основная проблема PANI заключается в том, что он плохо растворим в большинстве распространенных растворителей, что затрудняет экспериментальные исследования и ограничивает его промышленное использование. Матричная полимеризация анилина, нейтрализованного полимерными кислотами, имеет первостепенное значение как способ получения растворимых материалов, сочетающий электрофизические свойства полианилина (PANI) и механические свойства полимерных материалов. Мы использовали поли(2-акрил-амино-2-метил-1-пропан) сульфокислоту (PAMPSA) [2], отличающуюся регулярным распределением сульфокислотных групп вдоль основной цепи макромолекул. Предполагалось, что при протонировании анилина вышеуказанными поликислотами образующиеся макромолекулы PANI будут располагаться вдоль макромолекул поликислот и образовывать двухцепочечную макромолекулярную структуру интерполимерного комплекса. В этом случае конформации макромолекул поликислоты и РАМ изменяются для подгонки друг к другу. Синтез проводили при комнатной температуре при последовательном смешивании растворов PAMPSA, анилина и персульфата аммония в воде. Соотношение PAMPSA к анилину в реакционной смеси составляло 1:1 моль-единица/моль, а анилина к окислителю – 1:1.25 моль/моль. Концентрация анилина и PAMPSA в реакционной смеси 0.034 М/л. Проводящая форма соли эмеральдина (ES) может быть получена окислительным легированием лейкоэмеральдинового основания (LB) или протонированием (EB). Электропроводность пленки определяли по полианилину, синтезированному методом темплатного синтеза с PAMPSA, который отжимали на прозрачном стеклянном электроде ITO из водного раствора при 3500 об/мин.

Ферриты. В данном исследовании использовались ферриты производства Ярославского ОАО «Феррос». Ферриты бария использовались в виде небольших намагниченных шариков диаметром 3 мм и в виде порошка с дисперсией 30 мкм.

Производные графена. Среди многочисленных способов получения графена методы эксфолиации отличаются низкой стоимостью и технологической простотой процесса. Процесс эксфолиации имеет несколько смысловых значений: отшелушивание, расслоение, отслоение. К существующим методам эксфолиации относятся: СВЧ-обработка, отрывание скотчем, размол в шаровых мельницах, ультразвуковая обработка углерода в жидкой фазе и другие. Их классифицируют как физические методы, которые дают продукты высокого качества, но с малыми выходами (менее 5%), а также с низким латеральным размером чешуйки графена, менее 1 мкм.

Химическая эксфолиация, обычно ассоциируемая с методом Хаммерса для синтеза оксидов графена, — достаточно гибкий технологический метод с хорошим выходом продукта. Сущность метода — диффузия ионов из раствора

в межслойное пространство графитовых слоев под действием электрического поля. И катодный, и анодный потенциалы способны продвигать «гостевые» ионы, которые в дальнейшем осуществляют структурную деформацию в графите. Как правило, отслаивание графита выполнялось в двухэлектродной системе, при этом в качестве рабочих анолов использовалась графитовая фольга (коммерческая графитовая фольга Graflex $P\Phi$), а платиновая фольга — в качестве противоэлектродов. Чтобы избежать коротких замыканий (соединений между графитовой и Рt-пленками) во время отслаивания, графитовые пленки были свернуты в виде стержней. Пленки Рt располагали параллельно графитовым электродам на фиксированном расстоянии 2 см. В качестве электролита использовался сульфат аммония (3.0 М) в деионизованной воде. Процесс проводился при потенциале 10 В. Когда отслаивание было завершено, взвешенные графеновые листы собирали с помощью мембранного фильтра из ПТФЭ толщиной 0.2 мкм и промывали поочередно дистиллированной водой и этанолом путем вакуумной фильтрации. Темно-серый продукт был диспергирован в N. N-диметилформамиде (ДМФ) с помощью мягкой обработки ультразвуком (15 мин). Эта гомогенная суспензия выдерживалась в течение 12 часов после приготовления, чтобы осадить крупные хлопья. Графеновые листы затем переносили на подложку Si/SiO₂ с использованием метода Ленгмюра-Блоджетт. Сканирующая электронная микроскопия и энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (EMF) с помощью электронных микроскопов Supra-40 и Quanta 300і были использованы для изучения морфологии хлопьев графена на поверхности SiO₂, размера сотен микрометров и содержания углерода и кислорода в образце. Спектры комбинационного рассеяния света были получены с помощью спектрометра ENSPECTRR532. Анализ порошковых образцов продуктов эксфолиации методом рентгеновской дифракции проводили с использованием порошкового рентгеновского дифрактометра ДРОН 3М.

ИК-Фурье-спектроскопия. На рис. 1 отображены ИК-спектры исходной фольги (внизу) и продукта эксфолиации графита. Интенсивные полосы в области выше 3600 см⁻¹ связаны с колебаниями О–Н свободной воды, 3600–2700 см⁻¹ с О–Н гидроксилсодержащими соединениями с межмолекулярными



Рис. 1. ИК-спектры исходной фольги (внизу) и продукта эксфолиации графита

водородными связями, 1700–1660 см⁻¹ – валентные колебания карбонильных групп С=О. Ряд дополнительных полос может быть отнесен к метиленовым фрагментам $CH_2 - 2921$ см⁻¹, сульфонильные группы $SO_2 - 1424$ см⁻¹ [3]. Графит характеризуется теми же полосами поглощения за исключением карбонильных и сульфонильных.

Рентгеновская дифракция. На рис. 2а представлена дифрактограмма исходной фольги и продукта эксфолиации.

Межплоскостное расстояние d_{001} получается по закону Брэгга

$$2d_{001}\sin\theta = n\lambda,\tag{1}$$

где n = 2 – порядок дифракции; θ – угол Брэгга для гексагонального графитового пика (002); λ = 0.154185 нм – длина волны CuKa1. Средний размер когерентно дифрагирующих доменов L_c определяется по формуле Шеррера

$$L_c = \frac{0.91\lambda}{\beta\cos\theta}.$$
 (2)

Здесь β – скорректированная полная ширина в половине максимума пика (002). Чтобы определить β, мы используем следующую формулу:

$$\beta^2 = B^2 - b^2, \tag{3}$$

где *B* – FWHM пика (002) образца графита, а *b* – FWHM стандартного материала при том же угле дифракции. В расчетах учитывались как экспериментальные FWHM дифракционных пиков графита, так и корунда α -Al₂O₃NIST-1976а, причем последний использовался в качестве нашего стандарта. Количество слоев *N_c* вдоль оси «с» определяется как

$$N_c = 2L_c / d_{001}. (4)$$



Рис. 2а. Дифрактограмма исходной фольги (вверху) и продукта эксфолиации

Как отмечалось ранее [4], количество слоев кристаллитов N_c , определенное по формуле (4) вблизи пика $2\Theta \approx 26^\circ$, содержащего как 2H (002), так и 3R (003), может содержать ошибки, которые трудно точно исправить. Тем не менее образцы как графитовой фольги, так и отслаивающихся образцов содержат десятки слоев графена и в их составе присутствуют как фазы 2H, так и фазы 3R. На основе классификации, предложенной редакционной коллегией журнала «Углерод», образцы отслаивающегося графита, содержащие более 10 слоев, могут быть отнесены к нанографитам. Определение, согласно методу [4], количества слоев графена в кристаллите по данным дифрактограммы составило 15. Это позволяет классифицировать продукт как нанографит.

КР-спектроскопия. На рис. 26 показан спектр комбинационного рассеяния фольги и продукта эксфолиации. Полоса 2D (или G) также определяется атомами углерода sp^2 в виде одиночного пика или мультипликативной структуры в диапазоне 2500–2800 см⁻¹. Чувствительность 2D-пика к деталям структуры sp^2 делает эту полосу мощным индикатором для определения количества слоев графена в пучке. Уравнение (5) [5, 6], полученное для определения плотности дефектов n_D , или, другими словами, расстояния между дефектами кристаллической решетки графена, в зависимости от энергии возбуждающего излучения используется в видимом диапазоне, где лазерное возбуждение используется в пересчете на длину волны в нм. Для лазера с длиной волны 532 нм плотность дефектов n_D может быть представлена уравнением (5). Для сотовой идеальной решетки количество дефектов в уравнении (5) на n_C (6), если мы нормализуем количество дефектов в уравнении (5) на n_C , мы можем получить концентрацию дефектов на мм² в миллионных долях (промилле). Это соотношение обозначается в литературе как I_D/I_G , или I(D)/I(G):



$$n_{\rm D} = \left(2.4 \times 10^{22}\right) / \lambda_{\rm Laser}^4 \times \left(I_{\rm D} / I_{\rm G}\right);\tag{5}$$

Рис. 26. Спектр комбинационного рассеяния исходной фольги (вверху) и продукта эксфолиации

$$n_{\rm C} = 3.82 \times 10^7 \, (\mu^{-2}). \tag{6}$$

Согласно способу [6], дефект n_D/n_C , выраженный в миллионах частей на миллион, представляет собой незначительное значение в 18 частей на милли-он/мкм², который характеризует процесс как незначительно дефектный.

Получение СВЧ-поглощающих покрытий. В качестве мишени использовалось стекловолокно в форме равнобедренного треугольника с ребром длиной 300 мм, толщиной 0.8 мм, площадью ~390 см² и массой 33 г. Покрытие наносилось насыпью и кистью, в виде нескольких слоев с последовательной сушкой в сушильном шкафу при температуре 80 °C. В качестве связующего вещества 30% (по сухому остатку) использовали водный раствор поливинилацетатной эмульсии ДФ50/5Х. Диспергирование твердых веществ в эмульсии осуществляли с использованием лабораторного механического диспергатора в течение 20 мин. При необходимости эмульсию разбавляли деионизированной водой. В случае образца 2 (табл. 1) для улучшения смачивания использовали синтанол 10 в концентрации 1 мас. %. Толщина покрытий составляла 50–170 мкм.

№ п/п	Структура	Размеры частиц наполнителей	Плотность покрытия, г/см ² · 10 ⁻³	Потери на отражение (дБ) на частоте 10 ГГЦ	Поглощенная энергия,%
1	Феррит бария ВаFe ₁₂ O ₁₉	Феррит бария 3 мм (шары)	94	-14.3	96.3
	ВаFe ₁₂ O ₁₉ (1:1 по массе к 30% эмульсии)	Феррит бария 30 мкм (порошок)	10	-11.2	92.4
2	Нанографит 1:1 по массе к 30% эмульсии, 0.1% Синтанол-10	Нанографит 10—100 мкм, толщина 12 ± 3 нм	4.7	-14.4	96.4
3	Алюминиевый порошок РАР2 1:1 по массе к 30% эмульсии	Алюминиевый порошок 20—30 мкм	4.6	-11.8	93.4
4	PANI (эмеральдиновая соль, сульфокислоты)	Полианилин 27—29 нм	3.7	-13.3	95.3
5	Гибкий сверхширокочастот- ный радиопоглощающий материал на основе нано- структурированного ферро- магнитного микропровода [9]	JSC «CDBRPM» МРПК-1Л	10	-17	98

Таблица 1. Типы полимерных матриц, наполнителей, размеры частиц и их поглощающие свойства

Измерения. Микроскопическая морфология наноструктурированных гранулированных полимерных композитов и поперечное сечение полимерной матрицы, заполненной GNs, были выполнены с использованием сканирующей электронной микроскопии (SEM, Supra-40). Частицы полианилина имеют структуру, похожую на «малину»: мелкие зерна имеют размер 27–29 нм, крупные «ягоды» – 150–160 нм. Рентгеновская дифрактометрия наших образцов графитовой фольги и продуктов электрохимического отслаивания выявила наличие двух кристаллографических фаз: гексагональной 2H и орторомбической 3R. Рентгеновская дифрактометрия и электронная микроскопия показали, что отслаивающиеся образцы графита содержали кристаллиты практически вдвое меньшего нормального размера, которые имели по 30–50 слоев графена в каждом и могли быть классифицированы как нанографиты.

2. Результаты исследований

Портативный радар использовался для изучения поглощающих свойств электромагнитного излучения. Радиолокационный сигнал был обработан с использованием метода последовательной фильтрации. Согласованная фильтрация предполагает нахождение отклика фильтра в виде свертки входного сигнала радара x(t) и импульсной характеристики фильтра $h(t_0 - t)$, соответствующего сигналу зондирующего радара. При такой обработке выходного сигнала согласованного фильтра (SF) z(t) достигается максимальное отношение сигнал/ шум за счет накопления полезной энергии сигнала и подавления внеполосного шума. Для подавления возможных помех могут быть использованы дополнительные меры [2]. Испытуемый образец (мишень) располагался таким образом, чтобы находиться в зоне Фраунгофера (дальнее поле) на расстоянии от двух пар широкополосных радиолокационных антенн с круглой апертурой 5 см и полушириной луча 20°. Измерения отражения проводились при углах падения 0°, 60°, 120° к норме. Для каждого образца значения были усреднены по 100 параллельным сигналам; полученные данные были усреднены еще по 32 поляризациям и по 3-м углам падения. Затем данные были нормализованы по среднему значению отражения образца стеклопластиковой подложки без поглощающего покрытия.

Взаимосвязь между толщиной, проницаемостью и частотой минимальных потерь на отражение можно объяснить с помощью следующего уравнения:

$$f_m = \frac{C}{2\pi\mu d},\tag{7}$$

где f_m — частота согласования с минимальными потерями на отражение; C — скорость света; d — толщина образца; μ — мнимая часть магнитной проницаемости. Таким образом, из уравнения (7) легко определить, что частота согласования f_m смещается в сторону более низкой частоты с увеличением толщины образца [7]. Наноматериалы, обладающие новым механизмом поглощения волн, приводят к значительному поглощению электромагнитных волн в диапазоне ГГц с эффектами малого размера, анизотропии поверхности и формы. Согласно уравнениям собственного резонанса [8],

$$f_r = \gamma H_a / 2\pi; \tag{8}$$

$$H_a = \frac{4|K_1|}{3\mu_0 M_S};$$
(9)

$$K = \frac{\mu_0 M_S H_c}{2},\tag{10}$$

где f_r — резонансная частота; γ — гиромагнитное отношение; H_a — поле анизотропии; K — коэффициент анизотропии; μ_0 — проницаемость вакуума $(4\pi \times 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{A}^{-2})$; H_c — коэрцитивная сила; M_S — намагниченность насыщения. Из уравнений видно, что высокая энергия анизотропии связана с высоким коэффициентом анизотропии, а увеличение анизотропной энергии вызывает увеличение собственной резонансной частоты. Следовательно, можно настроить резонансную частоту путем изменения поля анизотропии магнитных частиц.

Считается, что энергия анизотропии материалов малого размера, особенно в нанометровом масштабе, была бы значительно увеличена из-за увеличения анизотропного поля поверхности, вызванного эффектом малого размера. В результате нанографитовое покрытие имеет коэффициент отражения мощности —14.4 дБ. Это значение близко к значению материала МРПК-1Л (—17 дБ) [9]. Но преимущество наноструктурированных гранулированных композитов, в частности нанографита, заключается в том, что толщина покрытия и вес меньше, чем у конкурентов, при той же степени отражения и поглощения электромагнитных волн.

Выводы

Показано, что на основе гранулированных наноструктур можно создавать материалы с комплексными магнитными и диэлектрическими свойствами в несколько раз выше, чем у традиционных ферритовых магнитных материалов. Эти материалы могут стать основой для создания эффективных широкополосных поглотителей электромагнитных волн толщиной в сотни микрон.

Работа выполнена в рамках Государственного задания ФТИАН им. К.А. Валиева РАН Минобрнауки РФ по теме № 0066-2019-0003. Некоторые экспериментальные результаты были получены на оборудовании Центра коллективного пользования «Диагностика микро- и наноструктуры» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Ресурс доступа: http://www.en.wikipedia/org/Potential applications of graphene
- Saveliev D., Grushevski E., Savinski N., Soloviev M., Turov V., Krenev V. The electromagnetic absorbers based nano – structuredgranular polymer-composites at gigahertz frequencies // J. Phys. Conference Ser. 2021. 2086. 012064.
- Soloviev M. E., Raukhvarber A. B., Savinski N. G., Irzhak V. I. Simulation and synthesis of graphene oxide from expanded graphite // Russian J. General Chem. 2017. Vol. 87 (4). P. 805–811.

- Savinski N. G., Melesov N. S., Parshin E. O., Vasiliev S. V., Bachurin V. I., Churilov A. B. Analyzing products of the electrochemical exfoliation of graphite via Rutherford backscattering and X-Ray diffractometry // Bulletin of the Russian Acad. Sci. Phys. 2020. Vol. 84 (6). P. 732–735.
- 5. *Grushevski E., Saveliev D., Mazaletski L., Savinski N., Puhov D.* The scalable production of high-quality nanographite by organic radical-assisted electrochemical exfoliation // J. Phys. Conference Ser. 2021. 2086. 012014.
- 6. Saveliev D. N., Grushevski E. A., Savinski N. G., Smirnova M. A., Mazaletsky L. A., Bachurin V. I., Churilov A. B. Electroporetic deposition of nanographite films and their investigation by the methods of structural analysis // Bulletin of the Russian Acad. Sci. Phys. 2022. Vol. 86 (5). P. 667–673.
- Mohd F., Idris I., Hashim M., Abbas Z., Nazlan R., Ibrahim I. Recent developments of smart electromagnetic absorbers basedpolymer-composites at gigahertz frequencies // J. Magnetismand Magnet. Mater. 2016. Vol. 405. P. 197–208.
- Kong J., Liu J., Wang F., Luan L., Itoh M., Machida K. Electromagnetic wave absorption properties of Fe₃O₄ octahedral nanocrystallines in gigahertz range // Appl. Phys. 2011. Vol. 105. P. 351–354.
- 9. Ресурс доступа: http://www.ckbrm.ru electromagnetic wave absorber PatentRU2322735C1.